PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07066207 A

(43) Date of publication of application: 10 . 03 . 95

(51) Int. CI

H01L 21/321 H01L 21/60 H05K 3/34

(21) Application number: 05209767

(22) Date of filing: 24 . 08 . 93

(71) Applicant:

SONY CORP

(72) Inventor:

ISHIKAWA NATSUYA

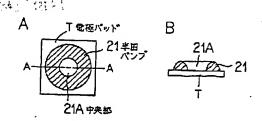
(54) SURFACE MOUNT DEVICE, MANUFACTURE THEREOF, AND SOLDERING METHOD

(57) Abstract:

PURPOSE: To solder a surface mount device to a circuit board without causing defective bonds by giving its electrodes solder bumps with a recess in the center so that they can seat on conductive projections on the board to correctly position the device.

CONSTITUTION: A surface mount device has electrodes T each provided with a solder bump 21 having a recess in the center. For example, a ring-shaped solder bump 21 with a recess 21A in the center is formed on the electrode pad of a surface mount device, such as a flip chip IC. Such a device is mounted on a circuit board in such a manner that the recessed bumps seat on conductive projections on the board. Then, the surface mount device is soldered to the board by heating.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-66207

(43)公開日 平成7年(1995)3月10日

(51) Int.Cl. ⁸ H 0 1 L 2	21/321	徽別記号			∌	庁内整理番号	FΙ		•		技術表示箇
	21/60	•	3 1	l 1	S	6918-4M 7128-4E					
						9168-4M 9168-4M	H01L	21/ 92		С	
			_				来葡萄	未請求	請求項の数4	F OL	(全 5 頁
(21)出顧番号		特顯平	5-20	976	57	•	(71) 出顧人	0000021			•
(22) 出顧日		平成5年(1993)8月24日							株式会社 品川区北品川 6 7	「目74	B 35号
							(72)発明者	石川 夏也 東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー 株式会社内			
							(74)代理人				
									•		
		-									

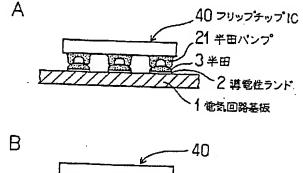
(54) [発明の名称] 表面実装型電子部品及びその製造方法並びに半田付け方法

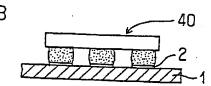
(57)【要約】 (修正有)

【目的】 表面実装型電子部品を電気回路配線基板に確 実に表面実装すること、

【構成】 フリップチップ型IC40の電極パッドTの表面上に半田バンプ21を形成し、その断面形状を凹状または台形状とした。このような半田バンプ21は、電極パッドTの少なくとも中央部表面を絶縁樹脂膜31で被覆し、この絶縁樹脂31で被覆されていない電極パッドTの表面上に半田34を付着させることにより形成している。

【効果】 この表面実装型電子部品の凹状または台形状の半田バンプが基板の凸状の導電性ランドに座り易くなるので、導電性ランド間にずり落ちることがなく、半田付け不良を起こさない。





1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面実装型電子部品の電極の表面上に、 断面が凹状または台形状の半田バンプを備えた表面実装 型電子部品。

【請求項2】 請求項1の表面実装型電子部品を、その 半田バンプの前記凹部または台形部が、電気回路配線基 板の電極に形成された断面が凸状の導電性ランドのその 凸部に座るように配置、合体し、その後、その合体状態 で両者を加熱処理して、前記表面実装型電子部品を電気 回路配線基板に半田付けすることを特徴とする表面実装 10 型電子部品の半田付け方法。

【請求項3】 表面実装型電子部品の電極の表面上に形成された半田バンプの少なくとも中央部に樹脂が充填されていることを特徴とする表面実装型電子部品。

【請求項4】 表面実装型電子部品の電極の少なくとも中央部表面を絶縁樹脂で被覆し、この絶縁樹脂で被覆されていない電極の表面上に半田を付着させて半田バンプを形成することを特徴とする表面実装型電子部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、例えば、フリップチップ型半導体集積回路装置(以下、単に「フリップチップ型IC」と記す)、或いは小型スイッチや狭ピッチのコネクターなどの表面実装型電子部品の電極に形成された半田バンプの構造及びその製造方法並びに半田付け方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来技術の表面実装型電子部品、例えば、フリップチップ型ICの電極の構造及びそのような 30 フリップチップ型ICを電気回路配線基板(以下、単に「基板」と記す)に表面実装した場合の様子を図7を用いて説明する。図7は従来技術のフリップチップ型ICを基板に表面実装した場合の状態を示した側面図である。

【0003】従来技術のこの種基板1は、ガラスエボキシ樹脂などの有機材やアルミナなどのセラミック材など、電気絶縁材で形成されており、その表面にやや突出して複数の導電性配線部とそれらの端部に形成された導電性ランド2とで電気回路が構成されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】所が、最近、フリップチップ型ICなどの表面実装型電子部品は高密度集積化、小型化されるようになり、それにつれ電極が多くなり、そしてそれらの電極が狭ピッチ化されるようになっている。また、このような表面実装型電子部品を実装する基板の前記導電性ランドも狭ピッチ化されるようになった。

【0005】狭ピッチ化されたフリップチップ型IC1 明の表面実装型スイッチを示していて、同図Aはその料 0を基板1に実装する場合は、導電性ランド2に被着し 50 視図、同図Bはその導電性端子の構造の平面図、同図C

た半田3の表面にフラックスを塗布し、その表面にフリップチップ型IC10を搭載するようにしているが、フラックスの流動により、図7に示したように、そのフリップチップ型IC10の半田バンプ11が導電性ランド2間にずり落ちてしまい、実装不良を起こすことがしばしば見受けられる。これらの原因は、前記フリップチップ型IC10の半田バンプ11が凸状の構造をしており、また前記導電性ランド2上の半田3も凸状の構造になっており、この凸状の半田3の上に前記凸状の半田バンプ11を載せ、接続させようとすることに起因するものであった。この発明は、このような実装不良を解決することを課題とするものである。

2

[0006]

【課題を解決するための手段】それ故、この発明では、表面実装型ICの電極表面上に半田バンプを形成し、その断面形状を凹状または台形状とした。そして、それら半田バンプの凹部または台形部が、基板に形成された断面が凸状の導電性ランドのその凸部に座るように配置、合体し、その後、その合体状態で両者を加熱処理して、20 前記表面実装型ICをその基板に半田付けする方法を採った。

【0007】また、このような半田バンプは、表面実装型電子部品の電極の少なくとも中央部表面を絶縁樹脂で被覆し、この絶縁樹脂で被覆されていない電極の表面上に半田を付着させることにより形成した。以上のような表面実装型電子部品の半田バンプの構造及びその製造方法並びに半田付け方法を採ることにより、前記課題を解決した。

[8000]

【作用】従って、この表面実装型電子部品の凹状または 台形状の半田バンプが基板の凸状の導電性ランドに座り 易くなるので、この表面実装型電子部品の半田バンプが 基板の導電性ランド間にずり落ちることがない。

[0009]

40

【実施例】先ず、この発明の表面実装型電子部品の構造及びその製造方法並びに半田付け方法の実施例を図1乃至図6を用いて説明する。図1はこの発明の表面実装型電子部品の半田バンプの構造の実施例を示していて、同図Aはその平面図、同図Bは同図AのAーA線上の断面側面図であり、図2はこの発明の表面実装型電子部品の半田バンプのその他の実施例の構造を示した平面図であり、図3は図1に示したこの発明の表面実装型電子部品の半田バンプの製造方法を説明するための工程図あり、図4はこの発明の表面実装型電子部品を基板に表面実装する半田付け方法を示していて、同図Aは基板にこの発明の表面実装型電子部品を基置した状態を示した断面側面図であり、同図Bは表面実装型電子部品が基板に半田付けされた状態を示した断面側面図あり、図5はこの発明の表面実装型スイッチを示していて、同図Aはその斜視図、同図Bはその導電性端子の構造の平面図、同図C

は同図BのAーA線上の断面側面図であり、そして図6 は図5に示した表面実装型スイッチを基板に表面実装す る半田付け方法を示していて、同図Aは基板にこの発明 の表面実装型スイッチを載置する状態を示した斜視図で あり、同図Bは表面実装型スイッチが基板に半田付けさ れた状態を示した断面側面図ある。なお、従来技術の表 面実装型電子部品などと同一の部分には同一の符号を付 して、それらの部分の説明を省略する。

【0010】図1に示した実施例のこの発明の表面実装 型電子部品の半田バンプ21は、その表面実装型電子部 品の電極パッドTの表面に、その中央部21Aが凹状に なるよう半田を環状に盛り上げた構造に形成されてい

【0011】図2に、図1に示した実施例の半田バンプ 21の構造と同一、またはほぼ同一の効果が得られる半 田バンプの構造を挙げた。同図Aの半田バンプ22は電 極パッドTの表面の四隅で、半田22aを半球状に盛り 上げ、それら4個の半田22aの中央部22Aで窪みを 形成した実施例である。同図Bの半田バンプ23は電極 パッド丁の表面の四隅で、半田23aを角錐状に盛り上 20 げ、それら4個の半田23aの中央部23Aで窪みを形 成した実施例である。 同図 C の半田バンプ 2 4 は電極 パッドTの表面の四辺に沿って、半田24aを盛り上 げ、それら四辺の半田24aの中央部24Aで窪みを形 成した実施例である。そして、同図Dの半田バンプ25 は電極パッドTの表面の二辺に沿って平行に、半田25 aを盛り上げ、それら二辺の半田25aが相対する中間 部25Aで窪みを形成した実施例である。

【0012】次に、表面実装型電子部品としてフリップ チップ型ICを実施例として挙げ、その電極バッドに、 図1に示した環状の半田バンプ21を形成する方法を図 3を用いて説明する. 先ず、同図Aの工程に示したよう に、フリップチップ型IC10の電極パッドTは、例え ば、一辺の長さLaが110μmの正方形のアルミで形 成されており、その電極パッドTの表面を一辺100μ mの正方形の開口部を残すようにしてSiO2 の絶縁膜 30で覆う。

【0013】次に、同図Bに示したように、感光性ポリ イミドを用いて電極パッドT上を外径90μmφ、内径 る. 次に、同図Cに示したように、スパッタ装置を用い て、第1層Cr、第2層Niの薄膜32をフリップチッ プ型IC10全体に成膜する。次に、同図Dに示したよ うに、感光性レジストを用いたフォトリソグラフィー法 を用いて、フリップチップ型IC10の電極パッドT付 近にCr、Niの2層膜32Aをパターニングする。こ の場合、電極バッドTの中心にある絶縁樹脂膜31の大 部分が露出するようにパターニングする。

【0014】次に、同図Eに示したように、図Dの工程

させるように厚膜感光性レジスト33を用いたフォトリ ソグラフィー法を用いてパターニングする。この場合、 Cr、Ni膜32Aが成膜されていない部分は、全て厚 膜感光レジスト33で覆われている。この工程に続い て、前記厚膜感光レジスト33の全表面から真空蒸着装 置を用いて、同図Fに示したように、半田34を成膜す

【0015】次に、同図Gに示したように、図Eの工程 で形成した厚膜感光レジスト33を剝離液を用いて除去 10 する。この時、厚膜感光レジスト33上に堆積した半田 34も同時に除去される。そして、次の最終工程でオー ブンを使用し、図Gの工程で作られた部品を加熱し、半 田34を溶融する。

【0016】この場合、図Gの工程で形成された半田3 4の膜厚が少なければ、図Hに示したように、フリップ チップ型IC10の電極パッドTの中心に設けられた絶 縁樹脂膜31上に半田34が堆積せず、半田バンプ21 が凹状の形をしたこの発明のフリップチップ型IC40 が得られ、また、図Gで形成された半田34の膜厚が厚 ければ、図Iに示したように、半田バンプ21Aの表面 がほぼ平らな台状のこの発明のフリップチップ型IC4 OAを得ることができる。以上のような工程を経て、図 1に示したこの発明の半田バンプ21をフリップチップ 型IC10の各電極パッドT上に形成することができ

【0017】次に、図4を用いて、この発明のフリップ チップ型IC40の基板1への表面実装方法を説明す る。先ず、基板1に形成された導電性ランド2上に半田 3を被着し、その半田3の表面にフラックスを塗布した 後、その表面にフリップチップボンダー用いて、この発 明のフリップチップ型IC40を載置する(図4A)。 【0018】この場合、図3Hのフリップチップ型 IC 40を導電性ランド2に載置した時は、その凹状の半田 バンプ21が導電性ランド2上の凸状の半田3に座るよ うに配置、合体することにより、フリップチップ型IC 40が導電性ランド2からずれるのを防ぐことができる (図4A).また、図Kのようなフリップチップ型IC 40Aを導電性ランド2の半田3上に載置した時は、そ の台状の半田バンプ21Aが導電性ランド2上の凸状の $30 \mu m \phi$ の二重円の絶縁樹脂膜 31をパターニングす 40 半田 3に座るように配置、合体することにより、前記半 田バンプ21程のずれ防止効果はないが、従来の凸状電 極と凸状の導電性ランドの接続と比較すれば遙にずれを 軽減するこができる。

> 【0019】最後に、オーブンを用い、この合体状態で 両者を加熱処理すると、図4Bに示したように、前記電 極パッドTと導電性ランド2とを半田接合させることが でき、フリップチップ型IC40、40Aを基板1に半 田付けできる。

【0020】次に、表面実装型電子部品の他の電子部品 でパターニングしたCr、Ni膜32Aの大部分を露出 50 として、表面実装型スイッチ(以下、単に「スイッチ」

と記す)を採り挙げ、図5及び図6を用いて、第2の実施例を説明する。

【0021】図5において、符号50はこの発明のスイッチを指しており、このスイッチ50は2個の導電性端の発明の発明の子51を備えている。これらの導電性端子51には、同図B、Cに示したように、中央部が窪んだ凹状の半田バンプ53が形成されている。この半田バンプ53は電極パッドTの中央部にエボキシ樹脂やシリコーン樹脂などで、同図の樹脂膜52を薄く塗布し、その後、この電極パッドTを半田にディップし、付着させることにより形成するこ10である。とができる。

【0022】このような構造のスイッチ50は、前記の第1の実施例のフリップチップ型IC40と同様に、その半田バンプ53に凹部が形成されているので、基板1に形成された導電性ランド2の半田3の凸部に座り良くなり、ずれ難くなる。従って、この状態で仮止めされた状態になり、この状態で基板1をリフローすることによりスイッチ50の導電性端子51と基板1に形成された半田の導電性ランド2とが半田付けされ、接続することができる(図6B)。なお、符号54はスイッチ50の20 T 摘みを指す。

[0023]

【発明の効果】以上説明したように、この発明の表面実装型電子部品を用いると、基板上に電子部品を表面実装し、電子部品の電極と基板の導電性ランドを半田接続する作業を行なっても、半田バンプと導電性ランドとがずれることなく接続することができ、半田付け不良を起こさない、信頼性の高い半田付けを行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の表面実装型電子部品の半田バンプ 30 の構造の実施例を示していて、同図Aはその平面図、同図Bは同図AのAーA線上の断面側面図である。

【図2】 この発明の表面実装型電子部品の半田バンプのその他の実施例の構造を示した平面図である。

【図3】 図1に示したこの発明の表面実装型電子部品の半田バンプの製造方法を説明するための工程図であ

る。

【図4】 この発明の表面実装型電子部品を基板に表面 実装する半田付け方法を示していて、同図Aは基板にこ の発明の表面実装型電子部品を載置した状態を示した断 面側面図であり、同図Bは表面実装型電子部品が基板に 半田付けされた状態を示した断面側面図である。

6

【図5】 この発明の表面実装型スイッチを示していて、同図Aはその斜視図、同図Bはその導電性端子の構造の平面図、同図Cは同図BのAーA線上の断面側面図である。

【図6】 図5に示した表面実装型スイッチを基板に表面実装する半田付け方法を示していて、同図Aは基板にこの発明の表面実装型スイッチを載置する状態を示した斜視図であり、同図Bは表面実装型スイッチが基板に半田付けされた状態を示した断面側面図である。

【図7】 従来技術のフリップチップ型ICの電極の構造及びそのフリップチップ型ICを基板に表面実装した場合の状態を示した側面図である。

【符号の説明】

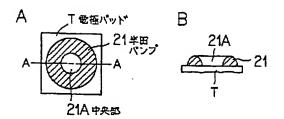
- 20 T 電極パッド
 - 1 電気回路配線基板(基板)
 - 導電性ランド
 - 3 半田
 - 21 断面凹状の半田バンプ
 - 21A 断面台形状の半田バンプ
 - 31 絶縁樹脂膜
 - 34 半田
 - 40 断面凹状の半田バンプを備えたフリップチップ

型IC

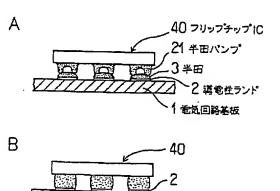
40A 断面台形状の半田バンプを備えたフリップチップ型IC

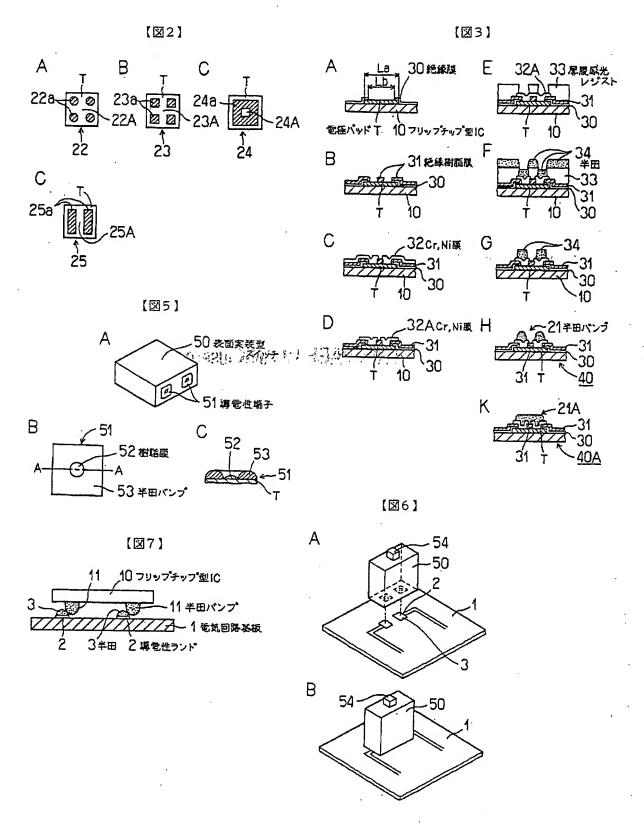
- 50 表面実装型スイッチ
- 51 導電性端子
- 52 樹脂膜
- 53 断面凹状の半田バンプ

【図1】



【図4】





THIS PAGE BLANK (USPTO)